

АП328А-2



ПОЛЕВЫЕ МАЛОЙ МОЩНОСТИ СВЧ
LOW POWER MICROWAVE FETs

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Двухзатворный арсенидгаллиевый с барьерами Шоттки и каналом n-типа проводимости планарный транзистор АП328А-2 предназначен для применения в усилителях и других устройствах СВЧ диапазона для внутреннего монтажа в гибридных интегральных микросхемах, обеспечивающих герметизацию и защиту транзисторов от воздействия влаги, соляного тумана, плесневых грибов, инея, росы, агрессивных газов и смесей, пониженного и повышенного давления, солнечной радиации.

Оформление - бескорпусное.

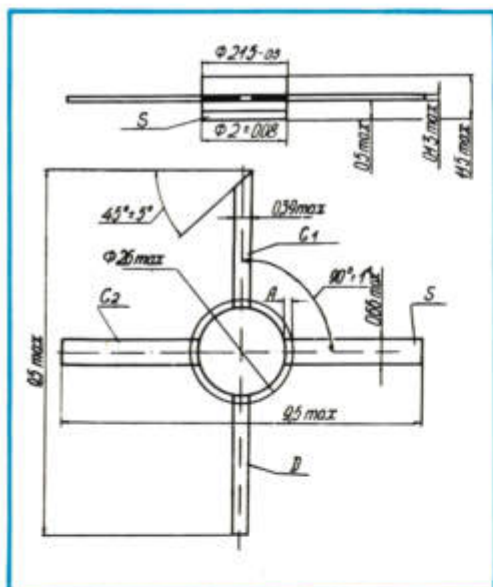
Диапазон допустимых рабочих температур от -60 до +85° С.

GENERAL DESCRIPTION

The АП328А-2 transistor is a two-gate planar n-channel GaAs MESFET designed for use in microwave amplifying and other circuits which are components of hybrid integrated circuits that provide hermetic sealing and protection of the transistor against the effects of moisture, salt spray, mouldy fungi, hoar-frost and dew, aggressive gases and mixtures, low and high pressures and solar radiation.

The device is an unpacked transistor.

Range of allowable operating temperatures - from -60 to +85° С.



ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ BASIC TECHNICAL CHARACTERISTICS

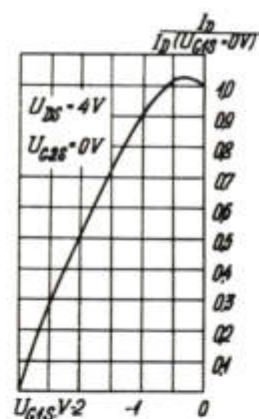
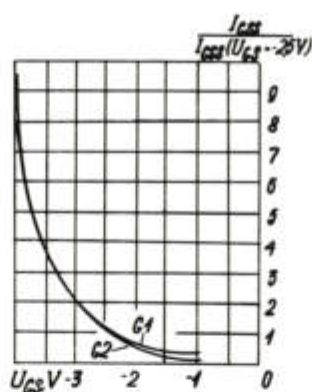
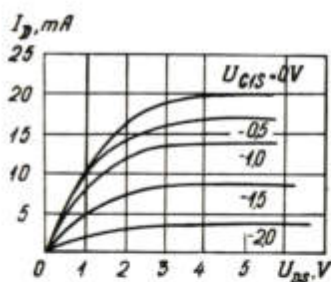
ПРЕДЕЛЬНЫЕ ЗНАЧЕНИЯ ДОПУСТИМЫХ РЕЖИМОВ ЭКСПЛУАТАЦИИ MAXIMUM VALUES OF ALLOWABLE OPERATING CONDITIONS

$U_{DS \max}$	6 V
$U_{G1S \max}$	-4 V
$U_{G2S \max}$	-6 V
$P_{DS \max}$	50 mW

АПЗ28А-2

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ ELECTRICAL PARAMETERS

Параметры Parameters	Значения Values	Режимы измерений Measuring conditions		
		$U_{DS}; U_{G1S}; U_{G2S}$, V	I_D , mA	f , GHz
I_{G1SS} , μA	≤ 1	$-2,5^H$		
I_{G2SS} , μA	≤ 1	$-2,5^{HH}$		
g_{ms1} , mA/V	≥ 7	$4; 0^{HH}$	8	$5 \cdot 10^{-6}$
g_{ms2} , mA/V	≥ 3	$4; 0^H$	8	$5 \cdot 10^{-6}$
F , дБ	$\leq 4,5$	$4; 0^{HH}$	8	8
G_p , дБ	≥ 9	$4; 0^{HH}$	8	8
$U_{GS1(off)}$	≤ 4	$4; 0^{HH}$	0,1	



АП328А-2

